

## 产品指标

### 1270nm-1630nm系列SLED

#### 产品描述

超辐射发光二极管(SLED)宽带光源,用于光纤陀螺、光纤传感、光学测试设备和光学相干影像等。它提供了波长范围包括O, E, S, C和L 波段的稳定光源。

我们的产品是一款宽带SLED,工作在一种与生俱来的超辐射模式下。与那种传统的、在更高电流发射更窄带宽的、基于ASE基础的SLED相比,这种超辐射特性在更高的驱动电流下产生了更宽的带宽。它的低相干性减少了反向散射噪音。高功率和宽光谱带宽的耦合,它抵消了光电接收器的噪音,并提高了占空分辨率(在OCT中)和测量灵敏度(在传感器中)。我们可以提供14-pin BTF封装,带驱动器的盒子以及台式整机多种版本。它遵照Telcordia GR-468-CORE的要求。

依靠我们宽光谱带隙工程技术,下一代SLED允许更高的芯片功率(高达50mW),和更宽的光谱(超过120nm)。更高水平的集成可以将SLED和相位调制器,光学耦合器以及光电探测器的特征集成在一个完整的光学传感芯片组中。

#### 特性

- 高稳定的功率输出
- 单模光纤输出
- 可选的驱动器盒子及台式整机
- 紧凑结构

#### 应用

- 光纤陀螺
- 光学测试设备
- 光纤传感
- 光纤通讯
- 光学相干影像
- 生物医疗影像设备
- 临床治疗设备

#### 产品系列

14管脚蝶形封装的 CSxxxxA	最小功率 (mW)	中心波长 (nm)	典型带宽 (nm)	典型光谱调制 (dB)
CS2184A	18	1270-1290	42	0.15
CS3102A	10	1290-1330	30	0.15
CS3152A	15	1290-1330	30	0.15
CS3184A	18	1290-1330	42	0.15
CS3202A	20	1290-1330	30	0.2
CS3452A	45	1290-1330	32	0.35
CS35H5A	13	1330-1370	48	0.2
CS40H2A	15	1380-1420	35	0.2
CS43H4A	15	1415-1445	45	0.2
CS44H4A	15	1430-1470	45	0.2
CS48H5A	15	1460-1550	50	0.2
CS5037A	3	1530-1570	60	0.15
CS5077A	5	1530-1570	60	0.2
CS5107A	8	1530-1570	60	0.2
CS5103A	10	1530-1570	40	0.15
CS5153A	15	1530-1570	40	0.2
CS5203A	20	1530-1570	40	0.25
CS5254A	25	1530-1570	40	0.25
CS5403A	35	1530-1570	40	0.35
CS58M7A	5	1560-1600	58	0.15

## 产品指标

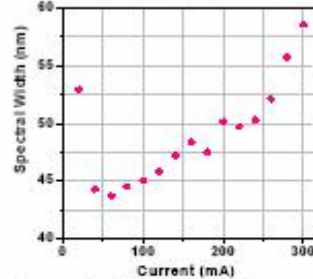
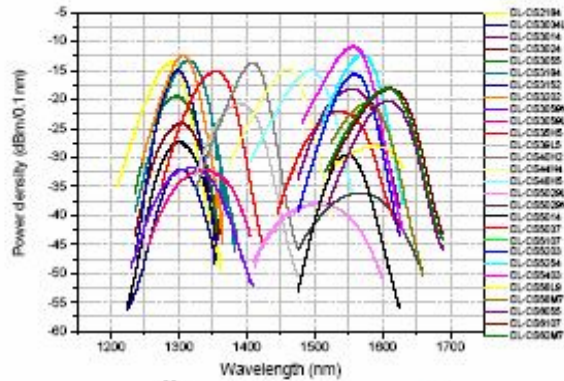
CS6055A	5	1580-1620	55	0.15
CS6107A	8	1580-1620	60	0.15
CS62M7A	8	1600-1630	65	0.15

波长段 (nm)	最小功率 (mW)	波长带宽 (nm)
1275	18	42
1310	0.3 - 20	43 - 70
1330	0.5	80
1350	15	48
1400	3 - 15	35 - 55
1440	15	45
1480	15	50
1510	0.2	100
1550	0.2 - 35	40 - 95
1600	2 - 8	55 - 65

### 其他诱人特性

- 高E/O效率，更低的耗电
- 高的TE/TM比（可>20dB）
- 直接调制高达622MHz
- 低的相干噪声
- 低的光谱抖动（0.1~0.2dB）
- 真正的与生俱来的超辐射模式

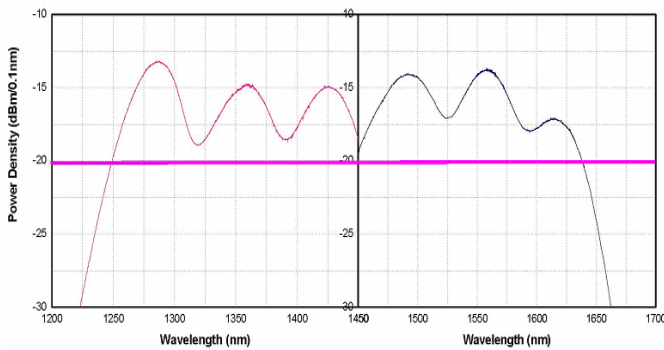
### 各种功率范围的SLED光谱图



真正的与生俱来的超辐射模式，与那种传统的、在更高电流发射更窄带宽的、基于ASE基础的SLED相比，这种超辐射特性在更高的驱动电流下产生了更宽的带宽。

### 多个SLED捆绑光谱曲线曲线

#### 捆绑6个SLED的光谱模拟图(dBm/0.1nm)



所用型号:

CS2184A CS48H5A

CS35H5A CS5153A

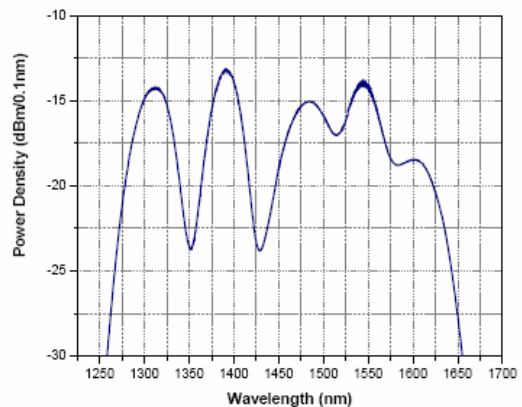
CS43H4A CS62M7A

功率密度的标度是dBm/0.1nm

如果采用dBm/nm为标度，功率密度会增加10dBm

捆绑时附加的耦合损耗未计算在内

#### 捆绑6个SLED的光谱模拟图(dBm/0.1nm)



所用型号: CS3184A (18mW); CS40H2A (18mW); CS48H5A (18mW); CS5153A (15mW); CS62M7A (10mW)  
功率密度的标度是dBm/0.1nm

如果采用dBm/nm为标度，功率密度会增加10dBm

捆绑时附加的耦合损耗未计算在内